## Фотовольтаический эффект Холла в двумерных флуктуирующих сверхпроводниках

 $M. B. Боев, B. M. Ковалев^{1)}$ 

Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН, 630090 Новосибирск, Россия

Новосибирский государственный технический университет, 630073 Новосибирск, Россия

Поступила в редакцию 9 августа 2024 г. После переработки 28 августа 2024 г. Принята к публикации 1 сентября 2024 г.

В работе обсуждается возможность существования фотовольтаического эффекта Холла – поперечного отклика двумерной системы со встроенным в плоскости системы постоянным тянущим электрическим полем – на внешнее циркулярно-поляризованное излучение вблизи точки фазового перехода системы в сверхпроводящее состояние со стороны нормальной фазы,  $T > T_c$ . Показано, что фотовольтаический эффект Холла может быть обусловлен сверхпроводящими флуктуациями в режиме, когда вклад в эффект нормальных электронов отсутствует.

DOI: 10.31857/S0370274X24100067, EDN: EZVBQA

1. Введение. Изучение стационарных токов носителей заряда в современных двумерных системах, индуцированных внешним высокочастотным полем, является активным направлением исследований в настоящее время [1]. В зависимости от симметрии двумерной системы, могут наблюдаться фотогальванические и фотовольтаические эффекты [2–13], эффекты фотонного увлечения носителей [14–16] и ряд других. В основе микроскопического описания таких явлений лежат симметрийные свойства: отсутствие пространственной инверсии кристаллической решетки или самой структуры приводит к особенностям электрон-фотонного, электрон-фононного и электрон-электронного взаимодействий в самых различных системах [1–20]. Следует отметить, что указанные фотоиндуцированные транспортные эффекты изучаются как в полупроводниковых [2–16], так и в сверхпроводящих системах [21–26]. В случае изотропных (в плоскости) двумерных систем, указанные эффекты могут иметь место если пространственная инверсия нарушена встроенным стационарным тянущим электрическим полем F, лежащим в плоскости двумерной системы. Среди большого разнообразия фотоиндуцированных транспортных эффектов особый интерес вызывает фотовольтаический эффект Холла (ФЭХ), заключающийся в появлении в поперечном к F направлении фотоиндуцированного тока. В случае внешнего циркулярно-поляризованного излучения, падающего по нормали к плоскости двумерной системы, плотность стационарного тока  $\Phi \ni X$  может быть записана в виде (рис. 1)

$$\mathbf{j} = i\gamma [\mathbf{F} \times [\mathbf{E} \times \mathbf{E}^*]],\tag{1}$$

где  $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E} \exp(-i\omega t) + \mathbf{E}^* \exp(i\omega t)$  – электрическое поле внешнего циркулярно-поляризованного излучения в плоскости двумерной системы,  $\gamma$  – частотнозависящий коэффициент, величина которого опрделяется конкретным микроскопическим механизмом эффекта. В случае сверхпроводящих систем, аналогом встроенного поля  $\mathbf{F}$  является встроенный в системе сверхток. Теория  $\Phi$ ЭХ недавно была разрабо-

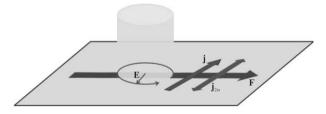


Рис. 1. (Цветной онлайн) Стационарный  $(\mathbf{j})$  и переменный  $(\mathbf{j}_{2\omega})$  фотовольтаический эффект Холла как отклик на циркулярное-поляризованное внешнее излучение

тана применительно к полупроводниковым двумерным системам с линейным и квадратичным спектром носителей заряда [27]. Одним из ключевых выводов разработанной теории является факт отсутствия циркулярного ФЭХ в случае, когда время релаксации импульса частицы не зависит от энергии частицы. Такая ситуация возникает для двумерных систем

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup>e-mail: vadimkovalev@isp.nsc.ru

с параболическим спектром носителей заряда: время релаксации импульса, описывающее процессы рассеяния носителей на короткодействующих примесных центрах, не зависит от их энергии (в случае линейной дисперсии двумерных носителей заряда, время релаксации импульса зависит от энергии даже в случае короткодействующих примесей). Применительно к сверхпроводящим системам, теория ФЭХ, описываемого выражением (1), была построена в работе [28]. Было показано, что ниже критической температуры,  $T < T_c$ , эффект имеет место вследствие того, что плотность состояний вблизи уровня Ферми сильно перестраивается при спаривании электронов, приводя к специфической зависимости времени релаксации импульса квазичастиц сверхпроводника от их энергии даже в случае параболической дисперсии и короткодействующих рассеивающих центров. В точке фазового перехода  $T=T_c$  плотность тока ФЭХ обращается в ноль, что согласуется с теорией  $\Phi \ni X$  для нормальных электронов в работе [27].

Цель настоящего сообщения заключается в том, чтобы теоретически показать возможность существования циркулярного  $\Phi \ni X$  выше  $T_c$  для системы нормальных электронов с независящим от энергии временем релаксации импульса. Если двумерная система может испытывать фазовый переход в сверхпроводящее состояние, то ФЭХ, описываемый выражением (1), может быть обусловлен наличием флуктуирующих куперовских пар вблизи  $T_c$  при  $T > T_c$ , даже если вклад нормальных электронов отсутствует. Следует отметить, что, в отличие от парапроводимости, когда сверхпроводящие флуктуации дают лишь поправку к друдевской проводимости [29], в случае ФЭХ сверхпроводящие флуктуации могут давать вклад в основной эффект на фоне нулевого вклада нормальных электронов.

Еще одним родственным эффектом, представляющим интерес в современной литературе, является переменный  $\Phi \Im X$  (ac Hall effect), когда поперечный к  $\mathbf{F}$  (в случае сверхпроводников – поперечный к встроенному стационарному сверхтоку) фотоиндуцированный ток осциллирует на удвоенной частоте внешнего излучения – явление, фактически представляющее собой эффект генерации второй гармоники [1,30–32]. В настоящем сообщении будет также изучен и переменный  $\Phi \Im X$ , обусловленный сверхпроводящими флуктуациями.

Теоретическое описание вклада сверхпроводящих флуктуаций в транспортные свойства сверхпроводников основывается либо на использовании временных уравнений Гинзбурга—Ландау, либо на использовании методов диаграммной техники [29]. В насто-

ящем кратком сообщении мы воспользуется иным подходом, предложенным Асламазовым и Ларкиным, и базирующемся на использовании кинетического уравнения, аналогичному уравнению Больцмана для нормальных электронов [29, 33]. Благодаря простоте такого подхода, он часто используется для описания высокочастотных откликов сверхпроводящих флуктуаций [21, 34–37].

**2. Флуктуационный ФЭХ.** Согласно подходу Асламазова и Ларкина, вклад флуктуаций определяется решением уравнения Больцмана для функции распределения флуктуаций

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{f - f_0}{\tau_{\mathbf{p}}} + 2e(\mathbf{F} + \mathbf{E}(t)) \cdot \nabla_{\mathbf{p}} f = 0.$$
 (2)

Здесь  $\mathbf{E}(t)=\mathbf{E}e^{-i\omega t}+\mathbf{E}^*e^{i\omega t}$  – вектор напряженности электромагнитной волны, падающей нормально на двумерную систему и оказывающей силовое воздействие на сверхпроводящие куперовкие пары, несущие заряд 2e. Равновесное состояние сверхпроводящих флуктуаций описывается функцией распределение Релея–Джинса,  $f_0=T/(\varepsilon_{\mathbf{p}}+\mu)$ , где  $\mu=\alpha T_c\epsilon$ ,  $\epsilon=(T-T_c)/T_c$  – приведенная температура,  $\varepsilon_{\mathbf{p}}=p^2/4m$ . Отметим, что здесь и далее температура в энергетических единицах и  $\hbar=1$ . Параметр  $\alpha$  уравнения Гинзбурга–Ландау выражается через длину когерентности  $\xi$  посредством соотношения  $4m\alpha T_c \xi^2=1$ , где

$$\xi^{2} = \frac{v_{F}^{2}\tau^{2}}{2} \left[ \psi \left( \frac{1}{2} \right) - \psi \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{4\pi T\tau} \right) + \frac{\psi'(1/2)}{4\pi T\tau} \right]$$
(3)

и  $\psi(x)$  — дигамма-функция. Эффективное время жизни куперовских пар, как и их равновесная функция распределения, выражается через кинетическую энергию центра масс куперовской пары  $\varepsilon_{\mathbf{p}} + \mu$  как  $\tau_{\mathbf{p}} = \pi \alpha/(16(\varepsilon_{\mathbf{p}} + \mu))$ . Данное обстоятельство является ключевым для флуктуационного механизма ФЭХ, обсуждаемого в настощей работе: даже если время релаксации импульса  $\tau$  нормальных электронов не зависит от их энергии, время жизни флуктуирующих куперовских пар  $\tau_{\mathbf{p}}$ , определющих ток ФЭХ, зависит от кинетической энергии пары.

В выражение (3) входит фермиевская скорость нормальных электронов,  $v_F$ , и время релаксации импульса нормальных электронов на примесях  $\tau =$  const. Для нахождения стационарного тока, ищем решение уравнения (2) итерациями по сумме полей  $\mathbf{F} + \mathbf{E}(t)$ . В результате, в первом порядке поправка

к функции распределения содержит стационарный и переменный вклады,  $f_1 = \overline{f}_1 + \tilde{f}_1(t)$ , где

$$\overline{f}_1 = -(2e)\tau_{\mathbf{p}}(\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}})f_0, \tag{4}$$

$$\tilde{f}_1(t) = -(2e)\left[\tau_{\omega}e^{-i\omega t}(\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}})f_0 + \tau_{\omega}^*e^{i\omega t}(\mathbf{E}^* \cdot \nabla_{\mathbf{p}})f_0\right],$$

и  $\tau_{\omega}=\tau_{\mathbf{p}}(1-i\omega\tau_{\mathbf{p}})^{-1}$ . Во втором порядке  $f_2=\overline{f}_2+\tilde{f}_2e^{-i\omega t}+\tilde{f}_2^*e^{i\omega t}$  (поправки на удвоенной частоте не дают вклад в стационарный ток)

$$\overline{f}_{2} = (2e)^{2} \tau_{\mathbf{p}} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) [\tau_{\omega}^{*} (\mathbf{E}^{*} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0}] + \\
+ (2e)^{2} \tau_{\mathbf{p}} (\mathbf{E}^{*} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) [\tau_{\omega} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0}], \\
\tilde{f}_{2} = (2e)^{2} \tau_{\omega} (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) [\tau_{\omega} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0}] + \\
+ (2e)^{2} \tau_{\omega} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) [\tau_{\mathbf{p}} (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0}], \\
\tilde{f}_{2}^{*} = (2e)^{2} \tau_{\omega}^{*} (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) [\tau_{\omega}^{*} (\mathbf{E}^{*} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0}] + \\
+ (2e)^{2} \tau_{\omega}^{*} (\mathbf{E}^{*} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) [\tau_{\mathbf{p}} (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0}].$$
(5)

Полный ток, обусловленный сверхпроводящими флуктуациями, определяется стационарной поправкой третьего порядка

$$\mathbf{j} = (2e) \sum_{\mathbf{p}} \mathbf{v}_{\mathbf{p}} \overline{f}_{3}, \tag{6}$$

$$\overline{f}_{3} = -(2e) \tau_{\mathbf{p}} (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \overline{f}_{2}$$

$$-(2e) \tau_{\mathbf{p}} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tilde{f}_{2}^{*} - (2e) \tau_{\mathbf{p}} (\mathbf{E}^{*} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tilde{f}_{2}.$$

Это выражение может быть преобразовано к виду, более удобному для дальнейших вычислений. Интегрируя один раз по частям, плотность тока может быть выражена через поправки второго порядка к функции распределения

$$\mathbf{j} = (2e)^2 \sum_{\mathbf{p}} \left[ \overline{f}_2 (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) + \tilde{f}_2 (\mathbf{E}^* \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) + \right.$$

$$\left. + \tilde{f}_2^* (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \right] (\mathbf{v}_{\mathbf{p}} \tau_{\mathbf{p}}).$$
(7)

Первый член здесь не дает вклада в циркулярный ток. Подставляя во второе и третье слагаемые в (7) выражения (5) и интегрируя еще раз по частям, получаем для тока общее выражение следующего вида

$$\mathbf{j} = -(2e)^{4} \sum_{\mathbf{p}} \tau_{\omega} \left[ (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0} \right] (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tau_{\omega} (\mathbf{E}^{*} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) (\mathbf{v}_{\mathbf{p}} \tau_{\mathbf{p}})$$

$$-(2e)^{4} \sum_{\mathbf{p}} \tau_{\mathbf{p}} \left[ (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0} \right] (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tau_{\omega} (\mathbf{E}^{*} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) (\mathbf{v}_{\mathbf{p}} \tau_{\mathbf{p}})$$

$$-(2e)^{4} \sum_{\mathbf{p}} \tau_{\omega}^{*} \left[ (\mathbf{E}^{*} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0} \right] (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tau_{\omega}^{*} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) (\mathbf{v}_{\mathbf{p}} \tau_{\mathbf{p}})$$

$$-(2e)^{4} \sum_{\mathbf{p}} \tau_{\mathbf{p}} \left[ (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0} \right] (\mathbf{E}^{*} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tau_{\omega}^{*} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) (\mathbf{v}_{\mathbf{p}} \tau_{\mathbf{p}}).$$

$$(8)$$

Выбирая направление постоянного поля вдоль оси x,  $\mathbf{F} = (F_x, 0)$ , можно убедиться, что в случае циркулярно-поляризованного излучения второе и четвертое слагаемые в (8) не дают вклада в выражение (1). Анализ оставшихся слагаемых в случае циркулярно- поляризованного излучения приводит к следующему выражению для плотности тока

$$j_{y} = -\frac{(2e)^{4}}{(2m)^{2}} \int \frac{d^{2}\mathbf{p}}{(2\pi)^{2}} [\tau_{\omega}(\tau_{\omega})' - \tau_{\omega}^{*}(\tau_{\omega}^{*})'] \varepsilon_{\mathbf{p}} \tau_{\mathbf{p}} f_{0}'$$
$$\times (E_{x} E_{y}^{*} - E_{x}^{*} E_{y}) F_{x}, \tag{9}$$

где  $\varepsilon_{\mathbf{p}} = \mathbf{p}^2/4m = m\mathbf{v}_{\mathbf{p}}^2$  и штрих означает взятие производной по энергии  $\varepsilon_{\mathbf{p}}$ . Сравнение выражения (9) с (1) дает для коэффициента  $\gamma$  выражение (восстанавливаем  $\hbar$  для размерности)

$$\gamma = \frac{2(2e)^4}{(2m)^2} \int \frac{d^2 \mathbf{p}}{(2\pi\hbar)^2} \left( \frac{\omega \tau_{\mathbf{p}}^3}{(1+\omega^2 \tau_{\mathbf{p}}^2)^2} \right)' \varepsilon_{\mathbf{p}} \tau_{\mathbf{p}} f_0'. \tag{10}$$

Интеграл в этом выражения удобно переписать в безразмерном виде

$$\gamma = \frac{(2e)^4}{2\pi} \left(\frac{\pi\alpha}{16}\right)^3 \left(\frac{T_c\hbar}{2m\mu^4}\right) \int_0^\infty \frac{2a_\omega (1-2x)dx}{(1+x)^3 [a_\omega^2 + (1+x)^2]^2},\tag{11}$$

где  $a_{\omega} = \pi \alpha \hbar \omega / 16 \mu$ . Теперь в (11) удобно рассмотреть предельные случаи. В области низких частот,  $a_{\omega} \ll 1$ , легко находим

$$\gamma = \frac{(2e)^4}{20\pi} \left(\frac{\pi\alpha}{16}\right)^3 \left(\frac{T_c\hbar}{m\mu^4}\right) a_\omega \sim \frac{\omega}{(T - T_c)^5},\tag{12}$$

а в области высоких частот,  $a_{\omega} \gg 1$ , получаем

$$\gamma = -\frac{(2e)^4}{2\pi} \left(\frac{\pi\alpha}{16}\right)^3 \left(\frac{T_c\hbar}{m\mu^4}\right) \frac{1}{2a_w^3} \sim \frac{-1}{\omega(T - T_c)}.$$
 (13)

Интеграл в (11) можно вычислить в общем случае, но финальное аналитическое выражение достаточно громоздко, поэтому соответствующее поведение  $\gamma(\omega)$  удобнее предствить в виде графика, рис. 2. Отметим высокую степень сингуляности по приведенной температуре в (12) и смену знака тока с ростом частоты.

**3.**  $\Phi$ луктуационный ac  $\Phi$ **ЭХ.** В настоящем разделе рассмотрим переменный ФЭХ. представляющий собой переменный поперечный к  $\mathbf{F}$  ток на удвоенной частоте падаюциркулярно-поляризованного излучения.  $\mathbf{j}^{(2\omega)} \exp(-2i\omega t) + \mathbf{j}^{(2\omega)*} \exp(2i\omega t)$ . Общее феноменологическое выражение для переменного ФЭХ имеет вид

$$\mathbf{j}(t) = \{\alpha \mathbf{F}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{E}) + \beta \mathbf{E}(\mathbf{F} \cdot \mathbf{E})\}e^{-2i\omega t} + \text{c.c.}$$
 (14)

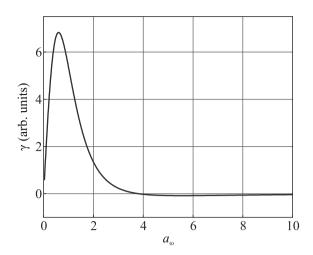


Рис. 2. (Цветной онлайн) Зависимость плотности тока ФЭХ от параметра  $a_{\omega}$ 

Для расчета эффекта генерации второй гармоники, определямого перменным током, требуются поправки второго и третьего порядка к функции распределения на удвоенной частоте внешнего излучения. Стандартным образом, изложенным в предыдущей секции, находим

$$\tilde{f}_{2}^{(2\omega)} = (2e)^{2} \tau_{2\omega} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tau_{\omega} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_{0}, \qquad (15)$$

$$\tilde{f}_{3}^{(2\omega)} = -(2e) \tau_{2\omega} (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tilde{f}_{2}^{(2\omega)} - (2e) \tau_{2\omega} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tilde{f}_{2},$$

и для амплитуды тока получаем выражение

$$\mathbf{j}^{(2\omega)} = (2e) \sum_{\mathbf{p}} \mathbf{v}_{\mathbf{p}} \tilde{f}_{3}^{(2\omega)} =$$

$$(2e)^{2} \sum_{\mathbf{p}} \left[ \tilde{f}_{2}^{(2\omega)} (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) + \tilde{f}_{2} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \right] (\mathbf{v} \tau_{2\omega}). \quad (16)$$

После подстановки (15) в (16) и интегрирования по частям, амплитуда тока принимает вид

$$\mathbf{j}^{(2\omega)} = -(2e)^4 \sum_{\mathbf{p}} \left[ \tau_{\mathbf{p}} (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_0 \right] (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tau_{\omega} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) (\mathbf{v} \tau_{2\omega})$$

$$-(2e)^4 \sum_{\mathbf{p}} \left[ \tau_{\omega} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) f_0 \right] \left[ (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tau_{\omega} (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) + (\mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \tau_{2\omega} (\mathbf{F} \cdot \nabla_{\mathbf{p}}) \right] (\mathbf{v} \tau_{2\omega}). \tag{17}$$

Это выражение применимо при любой поляризации излучения. В случае циркулярно-поляризованного излучения анализ (17) приводит к следующему выражению для амплитуды холловской компоненты перменного тока

$$j_{y}^{(2\omega)} = -\frac{(2e)^{4}}{(2m)^{2}} E_{y}(\mathbf{F} \cdot \mathbf{E}) \int \frac{d^{2}\mathbf{p}}{(2\pi)^{2}} f_{0}' \varepsilon_{\mathbf{p}}$$

$$\left[ (\tau_{\mathbf{p}} + \tau_{\omega}) [\tau_{\omega} \tau_{2\omega}' + (\tau_{\omega} \tau_{2\omega})' + \varepsilon_{\mathbf{p}} (\tau_{\omega} \tau_{2\omega}')'] + \tau_{\omega} [2\tau_{2\omega} \tau_{2\omega}' + \varepsilon_{\mathbf{p}} (\tau_{2\omega} \tau_{2\omega}')'],$$
(18)

где  $\tau_{2\omega} = \tau_{\mathbf{p}} (1 - 2i\omega \tau_{\mathbf{p}})^{-1}$ . Величина амплитуды тока (18) является комплекснозначной величиной. Сравниявая это выражение с (14) находим соотвествующий коэффициент

$$\beta = -\frac{(2e)^4}{2\pi 2m} \int_0^\infty d\varepsilon \, f_0' \Big\{ \varepsilon (\tau_\varepsilon + \tau_\omega) [\tau_\omega (\varepsilon \tau_{2\omega})']' + \frac{\tau_\omega}{2} [\varepsilon^2 (\tau_{2\omega}^2)']' \Big\}. \tag{19}$$

Зависимости величин  $\operatorname{Re} \beta$  и  $\operatorname{Im} \beta$  от частоты циркулярно-поляризованного излучения представлены на рис. 3.

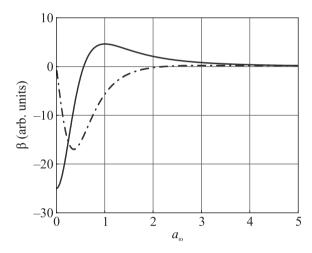


Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимости  $\operatorname{Re} \beta$  и  $\operatorname{Im} \beta$  от частоты циркулярно-поляризованного внешнего излучения (сплошная и штрихпунктирная кривые соответственно)

Заключение. В настоящем сообщении было показано, что фотовольтаический эффект Холла, индуцированный циркулярно-поляризованным излучением, может иметь место в двумерных системах даже в режиме, когда вклад нормальных электронов осутствует. В этом случае ФЭХ может быть обсуловлен сверхпроводящими флуктуациями вблизи точки перехода двумерной системы в сверхпроводящее состояние.

Авторы благодарят О.В. Кибиса за обсуждение результатов и полезные замечания.

Финансирование работы. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект #FSUN-2023-0006) и Фонда развития теоретической физики и математики "БАЗИС".

**Конфликт интересов.** Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

- M. M. Glazov and S. D. Ganichev, Phys. Rep. 535, 101 (2014).
- V. I. Belinicher and B. I. Sturman, Sov. Phys.-Uspekhi 23, 199 (1980).
- 3. E. L. Ivchenko and G. E. Pikus, *Problemy Sovremennoi Fiziki*, Nauka, Leningrad (1980).
- 4. S.D. Ganichev and W. Prettl, *Intense Terahertz Excitation of Semiconductors*, Oxford University Press, Oxford (2006).
- L. E. Golub, S. A. Tarasenko, M. V. Entin, and L. I. Magarill, Phys. Rev. B 84, 195408 (2011).
- M. V. Entin, L. I. Magarill and V. M. Kovalev, J. Phys.: Condens. Matter 31, 325302 (2019).
- E. Deyo, L. E. Golub, E. L. Ivchenko, and B. Spivak, arXiv:0904.1917 (2009).
- N. V. Leppenen and L. E. Golub, Phys. Rev. B 107, L161403 (2023).
- 9. L. E. Golub and M. M. Phys. Rev. B **106**, 205205 (2022).
- L. E. Golub, E. L. Ivchenko, and B. Spivak, Phys. Rev. B 102, 085202 (2020).
- M. V. Entin and V.M. Kovalev, Phys. Rev. B 104, 075424 (2021).
- A. V. Snegirev, V. M. Kovalev, and M. V. Entin, Phys. Rev. B 107, 085415 (2023).
- A. V. Snegirev, V. M. Kovalev, and M. V. Entin, Phys. Rev. B 109, 085422 (2024).
- J. Karch, P. Olbrich, M. Schmalzbauer et al. (Collaboration), Phys. Rev. Lett. 105, 227402 (2010).
- M. V. Entin, L. I. Magarill, and D. L. Shepelyansky, Phys. Rev. B 81, 165441 (2010).
- P. A. Obraztsov, N. Kanda, K. Konishi, M. Kuwata-Gonokami, S. V. Garnov, A. N. Obraztsov, and Y. P. Svirko, Phys. Rev. B 90, 241416(R) (2014).

- 17. O. V. Kibis, Phys. Lett. A **166**, 393 (1992).
- 18. O. V. Kibis, JETP 88, 527 (1999).
- 19. O. V. Kibis, Phys. Solid State 43, 2336 (2001).
- 20. O. V. Kibis, Physica E 12, 741 (2002).
- V. M. Kovalev, K. Sonowal, and I. G. Savenko, Phys. Rev. B 103, 024513 (2021).
- A. V. Parafilo, M. V. Boev, V. M. Kovalev, and I. G. Savenko, Phys. Rev. B 106, 144502 (2022).
- S. V. Mironov, A.S. Mel'nikov, and A.I. Buzdin, Appl. Phys. Lett. 124, 252601 (2024).
- S. V. Mironov, A. S. Mel'nikov, and A. I. Buzdin, Phys. Rev. B 109, L220503 (2024).
- S. V. Mironov, A.S. Mel'nikov, and A.I. Buzdin, Phys. Rev. Lett. 132, 096001 (2024).
- S. V. Mironov, A. S. Mel'nikov, I. D. Tokman,
   V. Vadimov, B. Lounis, and A. I. Buzdin, Phys. Rev. Lett. 126, 137002 (2021).
- 27. M. V. Durnev, Phys. Rev. B 104, 085306 (2021).
- A. V. Parafilo, V. M. Kovalev, and I. G. Savenko, Phys. Rev. B 108, L180509 (2023).
- A. I. Larkin and A. A. Varlamov, Theory of Fluctuations in Superconductors, Oxford University Press, Oxford (2005).
- 30. L.E. Golub and S.A. Tarasenko, Phys. Rev. B **90**, 201402(R) (2014).
- 31. M. V. Boev and V. M. Kovalev, JETP Lett. **116**, 173 (2022).
- K. Sonowal, A. V. Parafilo, M. V. Boev, V. M. Kovalev, and I. G. Savenko, 2D Materials 10, 045004 (2023).
- 33. L.G. Aslamazov and A.I. Larkin, in *Proceedings of the First European conference on condensed matter, European Physical Society*, Geneva, Switzerland (1971).
- T. Mishonov and D. Damianov, Czech. J. Phys. 46, 631 (1996).
- D. Damianov and T. Mishonov, Superlat. Microstr. 21, 467 (1997).
- T. M. Mishonov, A. I. Posazhennikova, and J. O. Indekeu, Phys. Rev. B 65, 064519 (2002).
- 37. T. M. Mishonov, G. V. Pachov, I. N. Genchev, L. A. Atanasova, and D. Ch. Damianov, Phys. Rev. B 68, 054525 (2003).